
	<p><b>SI7898DP-T1-E3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7898DP-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 150V 3A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7898DP-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 4194 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI7898DP-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 3A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	4194 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	85 mOhm @ 3.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI7898DP-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7898DP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7898DP-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7898DP-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI7900AEDA-T1-E3</b> VISHAY VISHAY VSSOP-8</p>	 <p><b>SI7898DP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 3A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7892DP-T1-E3</b> VISHAT SI7892DP-T1-E3 VISHAT</p>	 <p><b>SI7892DP-T1-GE3</b> VB SI7892DP-T1-GE3 VB</p>
 <p><b>SI7900ADN</b> SI SI7900ADN SI</p>	 <p><b>SI7898DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 3A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7898DP-T1-E3.</b> VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p><b>SI7898DP</b> SI SI7898DP SI</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI7886ADP-T1-E3	 SI7886ADP-T1-E3	 SI7886ADP-T1-GE3	 SI7886ADP-T1-GE3	 SI7886DP
 SI7886DP-T1	 SI7886DP-T1-E3	 SI7886DP-T1-GE3	 SI7888DP-T1-E3	 SI7888DP-T1-E3
 SI7888DP-T1-GE3	 SI7888DP-T1-GE3	 SI7892ADP-T1-E3	 SI7892ADP-T1-GE3	 SI7892ADP-T1-GE3.
 SI7892BDP-T1-E3	 SI7892BDP-T1-E3	 SI7892BDP-T1-GE3	 SI7892BDP-T1-GE3	 SI7892DP
 SI7892DP-T1	 SI7892DP-T1-E3	 SI7892DP-T1-GE3	 SI7898DP	 SI7898DP-T1-E3
 SI7898DP-T1-GE3	 SI7898DP-T1-GE3	 SI7900ADN	 SI7900AEDN	 SI7900AEDN-T1
 SI7900AEDN-T1-E3	 SI7900AEDN-T1-E3	 SI7900AEDN-T1-GE3	 SI7900AEDN-T1-GE3	 SI7900EDN
 SI7900EDN-T1	 SI7900EDN-T1-E3	 SI7900EDN-T1-GE3	 SI7901EDN-T1	 SI7901EDN-T1-E3
 SI7901EDN-T1-E3	 SI7904BDN-T1-E3	 SI7904BDN-T1-E3	 SI7904BDN-T1-GE3	 SI7904BDN-T1-GE3
 SI7904DN	 SI7904DN-T1	 SI7904DN-T1-E3	 SI7904DN-T1-E3	 SI7904DN-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited